## 3A01 一般化フェリ磁性の孤立系モデルにおける交換相互作用と基底スピン状態

(阪市大院理<sup>1</sup>・科学技術振興機構さきがけ<sup>2</sup>) 〇前川健典<sup>1</sup>, 伊瀬智章<sup>1, 2</sup>, 塩見大輔<sup>1,2</sup>, 佐藤和信<sup>1</sup>, 工位武治<sup>1</sup>

以前我々は、二重項モノラジカル(S = 1/2)と 基底一重項ビラジカル(S = 0)からなる反強磁 性交互1次元鎖(図 1)について、Heisenberg モ デルを用いた理論的考察を報告している[1]. この理論計算から、交互1次元鎖は分子内( $J_1$ ) および分子間交換相互作用( $J_2, J_3$ )の相対的な 大きさにより三種の基底状態を取り得ること を指摘した.一つは非磁性(反磁性)、他の二つ はフェリ磁性(一般化フェリ磁性)状態である.

本研究では、上記の交互1次元系(分子集合系)の一部を取り出した孤立モデル系として、基底一重項ビラジカルと遷移金属イオンからなるバタフライ型二核錯体(図 2)の理論的考察を行った。バタフライ型二核錯体は、交互1次元鎖(図 1)から、一般化フェリ磁性の本質である、基底一重項ビラジカルを含む三角フラストレーション系のみを抽出したものである。ビラジカル( $S_{R1} = S_{R2} = 1/2$ )内の交換相互作用 $J_1$ 、及びビラジカルー金属イオン( $S_M$ )間の交換相互作用 $J_2$ 、 $J_3$ 、 $J_4$ 、 $J_5$ は反強磁性的であると仮定している。また遷移金属イオンとして Cu(II)( $S_M = 1/2$ )



図1 基底一重項(S = 0)ビラジカルと二重項 (S=1/2)モノラジカルの交互一次元鎖モデル



図 2 バタフライ型モデル  $(S_{R1} = S_{R2} \equiv S_R = 1/2, S_{M1} = S_{M2} \equiv S_M = 1/2, 1, 5/2)$ 

あると仮定している.また遷移金属イオンとして Cu(II)( $S_M = 1/2$ ), Ni(II)( $S_M = 1$ ), Mn(II)( $S_M = 5/2$ )を想定した.このモデルのスピンハミルトニアンは

$$H = -2J_1 \mathbf{S}_{R1} \bullet \mathbf{S}_{R2} - 2J_2 \mathbf{S}_{R1} \bullet \mathbf{S}_{M1} - 2J_3 \mathbf{S}_{R2} \bullet \mathbf{S}_{M1} - 2J_4 \mathbf{S}_{R1} \bullet \mathbf{S}_{M2} - 2J_5 \mathbf{S}_{R2} \bullet \mathbf{S}_{M2}$$
(1)

と書ける. ビラジカルー金属イオン間の交換 相互作用を全て共通( $J_2 = J_3 = J_4 = J_5$ :モデル 1)としたスピンハミルトニアン(1 式)の厳密 対角化から,バタフライ型二核錯体は交換相 互作用の相対的な大小関係に依存して二種 の基底状態A, B(図3)をとることがわかった. 基底状態A では全スピンは $S_T = 2S_M$ -1となり, ビラジカル部のスピン $S_b = S_{R1}+S_{R2}$ の期待値  $< S_b^2 > t < S_b^2 > ~ 2 (S_{R1}+S_{R2} ~ 1)$ となった. 基底



図3 バタフライ型二核錯体の基底状態

状態 A は, 上記の交互 1 次元鎖における一般化フェリ磁性状態と本質的に同等のものである. 一方,基底状態 B は( $2S_M$ +1)重に縮退していた( $S_T = 0, 1, \dots 2S_M$ の状態からなる).このスピン 縮退は、ビラジカル部がほぼ純粋な一重項(S = 0)になっているためであると考えられる. 実際,基底状態 B のビラジカル部のスピンの期待値を計算すると $<S_b^2 > ~0$ ( $S_{R1}+S_{R2} ~ 0$ )である ことが確かめられた.また、ビラジカルー金属イオン間の交換相互作用の空間的対称性が異 なる 3 種のモデル( $J_2 = J_5, J_3 = J_4 : \pi \pi \nu 2$ ), ( $J_2 = J_4, J_3 = J_5 : \pi \pi \nu 3$ ), ( $J_2 = J_3, J_4 = J_5 : \pi \pi \nu 4$ )でも同様の理論計算を行った.モデル 2 から 4 においても、上述した二種の基底状態 A, B をとることがわかった.さらに、交換相互作用の空間的対称性、及び金属イオンのもつ スピン量子数の違いを反映した特異な基底状態も存在 しており,複雑な基底スピン状態をとることがわかった.

現実の分子系でバタフライ型フラストレーション系 錯体を得るために,基底一重項ビラジカルとしてニトロ ニルニトロキシドビラジカル bnn とイミノニトロキシ ドビラジカル bin(図 4)を用いて錯体の合成を試みた[2]. bnn からは理論モデル 1 の, bin からは理論モデル 2,も しくは理論モデル 4 のモデル錯体が得られる可能性が ある.すでに bnn と Mn(II)(hfac)<sub>2</sub>からなるバタフライ型



図4 基底一重項ビラジカル

二核錯体[3]が一例のみ報告されており、磁化率や強磁場磁化曲線の測定から、この錯体の基 底スピン量子数は $S_{T}$  = 4(我々のモデル計算の基底状態Aに相当する)であると結論されている [3]. 金属イオンのスピン量子数 $S_{M}$ を反映した特異な基底状態を探索するため、Mn(II)のほか に、Cu(II)や Ni(II)の塩を用いて錯体を合成した.

CuCl<sub>2</sub>, CuBr<sub>2</sub>と bin から二種の錯体[(CuCl<sub>2</sub>)(bin)] (1), [(CuBr<sub>2</sub>)(bin)] (2)を得た.元素分析の 結果から CuCl<sub>2</sub>, CuBr<sub>2</sub>と bin の比が 1:1 であることを確認した.これらの磁化率 $\chi_p$ の測定結 果を図 5 と図 6 に示す.元素分析から得られた組成からは,交互 1 次元系,もしくは孤立系 としての 3 スピン系 (バタフライ型錯体から S<sub>M2</sub>を除いたもの) [1], [5]ができていると考え られる.これらのモデルを仮定して磁化率の解析を行ったが、実測を再現することはできて いない.正しいモデルを得るために,現在錯体(1)と(2)の X 線結晶構造解析を行っている.



図5 錯体[(CuCl<sub>2</sub>)(bin)](1)の<sub>20</sub>T-Tプロット 図6 錯体[(CuI

図 6 錯体[(CuBr<sub>2</sub>)(bin)](2)のχ<sub>p</sub>T-Tプロット

[1] D. Shiomi, K. Sato, and T. Takui, J. Phys. Chem. B., 105, 2932(2001).

[2] (a) E. F. Ullman and D. G. B. Boocock, *J. Chem. Soc. Chem. Commun.*,1161(1969). (b) R. Weiss and N. Krant, *Angew. Chem. Int. Ed. Eng.*, **41**, 311(2002).

[3] (a) M. Tanaka, K. Matsuda, T. Itoh, and H. Iwamura, Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 37, 810(1998).

(b) Y. Inagaki, T. Asano, Y. Ajiro, T. Kawae, K. Takeda, H. Nojiri, M. Motokawa, H. Mitamura, T.

Goto, M. Tanaka, K. Matsuda and H. Iwamura, Mol. Cryst. and Liq. Cryst., 343, 115(2000).

[4] 前川健典・伊瀬智章・塩見大輔・佐藤和信・工位武治, 第84化学会年会, 2A306(2004).